Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем проектирования в микроэлектронике Российской академии наук (ИППМ РАН)

Библиотека схемотехнических решений

Активный RC-фильтр нижних частот третьего порядка на операционном усилителе с парафазным выходом

Денисенко Д.Ю., <u>d.u.denisenko@gmail.com</u> Титов А.Е., <u>alex.evgeny.titov@gmail.com</u> Иванов Ю.И., <u>viivanov@sfedu.ru</u> Свизев Г.А., <u>grits1989@mail.ru</u>

Научно-исследовательская лаборатория проблем проектирования в экстремальной микроэлектронике ИППМ РАН и Донского государственного технического университета (г. Ростов-на-Дону)

1. Области применения

В системах автоматического управления, в различных аналогоцифровых преобразователях (АЦП) часто применяются аналоговые активные (ФНЧ), RC-фильтры нижних частот которые выполняют функцию ограничителей спектра входных сигналов. Так, АЦП с дифференциальным антиэлайзинговых подразумевают использование ФНЧ входом дифференциальным выходом.

Существенным недостатком известного ФНЧ рис. 1 [1], является то, что при его реализации не обеспечивается высокое ослабление паразитных сигналов за пределами полосы частот полезного сигнала.



Рисунок 1 – Схема классического ФНЧ с дифференциальными входом и выходом [1]

2. Текстовое описание предлагаемой схемы ФНЧ рис. 2

В предлагаемом ФНЧ третьего порядка [2] (рис. 2) обеспечивается увеличение крутизны амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в переходной области и увеличение затухания АЧХ в полосе задерживания. Данный эффект достигается за счет повышения порядка ФНЧ, причем без применения дополнительных активных элементов.



Рисунок 2 – Схема ФНЧ третьего порядка [2]

В общем случае передаточная функция схемы ФНЧ 3-го порядка, в т.ч. рис. 2, описывается выражением [3,4,5]

$$F(p) = \frac{U_{\text{Bbix}}(p)}{U_{\text{Bx}}(p)} = M \frac{a_0}{p^3 + a_2 p^2 + a_1 p + a_0},$$
(1)

где M – коэффициент передачи фильтра на нулевой частоте, $a_2 \dots a_0$ – коэффициенты передаточной функции, зависящие от топологии схемы и параметров её элементов.

При анализе введем следующие обозначения: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 – сопротивления резисторов R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 соответственно, C1, C2, C3, C4, C5, C6 – емкости конденсаторов C1, C2, C3, C4, C5, C6 соответственно.

При выполнении ряда условий

$$\begin{aligned} R_1 &= R_2, \ R_3 = R_4, \ R_5 = R_6, \ R_7 = R_8, \\ C_1 &= C_2; \ C_3 = C_4, \ , \ C_5 = C_6, \end{aligned}$$

которые необходимо обеспечить в схеме рис. 2 для симметричной работы каналов ФНЧ, коэффициенты передаточной функции (1) находятся с помощью следующих формул

$$M = \frac{R_7}{R_1},$$

$$a_2 = \frac{1}{R_7 C_3} + \frac{1}{R_3 C_5} + \frac{1}{R_1 C_3} + \frac{1}{R_5 C_5} + \frac{1}{R_3 C_3} - \frac{1}{R_5 C_8},$$

$$a_1 = \frac{1}{R_3 R_7 C_3 C_5} + \frac{1}{R_7 R_5 C_3 C_5} + \frac{1}{R_1 R_3 C_3 C_5} + \frac{1}{R_1 R_5 C_3 C_6} + \frac{1}{R_1 R_5 C_3 C_6} - \frac{1}{R_1 R_5 C_3 C_8} - \frac{1}{R_3 R_5 C_3 C_5} - \frac{1}{R_3 R_5 C_3 C_8},$$

$$a_0 = \frac{1}{R_3 R_5 R_7 C_3 C_5 C_8}.$$

$$(2)$$

3. Компьютерное моделирование ФНЧ рис. 2

ФНЧ рис. 2 моделировался в среде McroCap11 в соответствии со схемой рис. 3.



Рисунок 3 – Схема ФНЧ третьего порядка рис.2 в среде MicroCap11

На рис. 4 представлено сравнение трех АЧХ предлагаемой схемы ФНЧ, полученных при компьютерном моделировании на ОУ THS4131 («1»), AD8132 («2») и теоретических расчетах («3»), выполненных по формуле (1).



Рисунок 4 - Сравнение трех АЧХ предлагаемой схемы ФНЧ

Незначительное отклонение в области высоких частот амплитудночастотной характеристики, полученной в результате моделирования схемы с реальными ОУ («1», «2») от АЧХ, полученной расчетным путем («3») по формуле (1), связано с влиянием частотных свойств ОУ, которое не учитывалось при нахождении коэффициентов (2) передаточной функции (1).

Следовательно, предлагаемая схема обеспечивает практически идеальную теоретическую АЧХ «3» ФНЧ третьего порядка в частотном диапазоне до 50-80 МГц. При этом на данных частотах ФНЧ дает ослабление сигнала более 120 дБ, что достаточно для многих применений.

Кроме этого, схема рис. 2 имеет более высокую крутизну АЧХ в переходной области и повышенное затухание АЧХ в полосе задерживания. Данный эффект достигается за счет повышения порядка ФНЧ, причем без применения дополнительных активных элементов.

Таким образом, предлагаемый ФНЧ, в сравнении с классическим, имеет более высокие обобщенные показатели качества.

Разработка выполнена в рамках гранта Российского научного фонда (проект № 18-79-10109)

Netlist схемы ФНЧ рис. 3

```
* Converted From Micro Cap Source file to PSPICE
.FUNC DPWR(D) \{I(D) * V(D)\}
.FUNC BPWR(Q) {IC(Q)*VCE(Q)+IB(Q)*VBE(Q)}
.FUNC FPWR(M) {ID(M) *VDS(M)}
.FUNC HOTD(D,MAX) {IF((V(D) \times I(D) > MAX), 1, 0)}
.FUNC HOTB(Q,MAX) { IF((VCE(Q) * IC(Q) + IB(Q) * VBE(Q) > MAX), 1, 0) }
.FUNC HOTF(M, MAX) { IF((VDS(M) * ID(M) > MAX), 1, 0) }
.PARAM LOW3MIN={IMPORT(LOW3MIN.OUT,LOW3THRES)}
.PARAM HIGH3MAX={IMPORT(HIGH3MAX.OUT, HIGH3THRES)}
.PARAM LOWLVDS={IMPORT(LOWLVDS.OUT,LOWLIMIT)}
.PARAM HILVDS={IMPORT(HILVDS.OUT, HILIMIT)}
.PARAM LIMTLVDS={IMPORT(LIMTLVDS.OUT,LVDSLIMITS)}
.FUNC SKINAC (DCRES, RESISTIVITY, RELPERM, RADIUS)
{ ((PI*RADIUS*RADIUS) / ((PI*RADIUS*RADIUS) - PI* (RADIUS-
SKINDEPTHAC (RESISTIVITY, RELPERM) ) **2) ) *DCRES }
.FUNC SKINDEPTHAC (RESISTIVITY, RELPERM)
{503.3*(SQRT(RESISTIVITY/(RELPERM*F)))}
.FUNC SKINTR (DCRES, RESISTIVITY, RELPERM, RADIUS, FREQ)
{ ((PI*RADIUS*RADIUS) / ((PI*RADIUS*RADIUS) - PI* (RADIUS-
SKINDEPTHTR(RESISTIVITY, RELPERM, FREQ))**2))*DCRES}
.FUNC SKINDEPTHTR (RESISTIVITY, RELPERM, FREQ)
{503.3*(SQRT(RESISTIVITY/(RELPERM*FREQ)))}
C14 11 0 3182e-12
C15 13 8 1591e-12
C16 14 9 1591e-12
C17 6 9 1591e-12
C18 7 8 1591e-12
C19 0 10 3182e-12
R38 9 10 10k
R39 11 8 10k
R40 10 13 10k
R41 11 14 10k
R42 13 6 23.5k
R43 14 7 23.5k
R44 5 10 10k
R45 0 11 10k
V4 VC 0 DC 15
V5 VE 0 DC -15
V13 3 0 DC 15
V14 0 4 DC 15
V15 INTERIOR NONE1 0 AC 1 SIN (0 1 2000 0 0 0)
RV15 5 INTERIOR NONE1 0.001 ;added by V15
X15 6 7 3 4 8 9 0 THS4131
```

```
X16 9 8 OutPF4 SUB PARAMS: KA=1 KB=1
*
*** From file F:\MC11\library\SUB.MAC
.SUBCKT SUB PinA PinB PinC PARAMS: KA=1 KB=1
E1 PINC 0 VALUE = {KA*V(PINA)-KB*V(PINB)}
.ENDS SUB
*
*** From file F:\MC11\library\TI.LIB
.SUBCKT THS4131 1 2 3 4 5 5b 17
*
* INPUT *
Q1
           27 1 28 NPN IN 2
Q2
           25 2 29 NPN IN 2
R2
           26 29 15
R1
           26 28 15
* SECOND STAGE *
Q3
           07 Vref 27 PNP 2
           09 Vref 25 PNP 2
Q4
Q5
           07 105 06 NPN 1
 Q7
           09 105 08 NPN 1
           4 06 333
RЗ
R4
           4 08 333
            0 09 25.5p
Сс
Ccb
           0 07 25.5p
* HIGH FREQUENCY SHAPING *
Ehf
            34 0 09 0 1
Lhf
            34 35 7n
            102 35 25
Rhf
           0 102 23p
Chf
             24 0 07 0 1
Ehfb
             24 33 7n
Lhfb
             12 33 25
Rhfb
           0 12 23p
Chfb
* OUTPUT *
08
           102 102 103 PNP 1
           102 102 104 NPN 1
09
           3 103 30 NPN 5
 Q10
           4 104 31 PNP 7.5
 Q11
R5
           5 30 4
R7
           31 5 4
           12 12 13 PNP 1
 Q8b
            12 12 15 NPN 1
 Q9b
         3 13 22 NPN 5
 Q10b
```

4 15 23 PNP 7.5 011b R5b 5b 22 4 R7b 23 5b 4 * Vcm ERROR AMP * 0 105 16 17b 1e-4 Gcm Vcm 17 17b 285e-3 Rtop 17 3 30k 17 4 30k Rbot 16 5 10k Rcm 16 5b 100p Ccm Rcm2 16 5b 10k Ccm2 16 5 100p * BIAS SOURCES * 3 Vref 1.85 V1 3 27 DC 2.1e-3 I1 3 25 DC 2.1e-3 I2 I3 0 103 DC 1.225e-3 26 4 DC 2.1e-3 I4 104 0 DC 1.86e-3 Ι5 0 13 DC 1.225e-3 I6 15 0 DC 1.86e-3 Ι7 .MODEL NPN IN NPN + IS=170E-18 BF=400 NF=1 VAF=100 IKF=0.0389 ISE=7.6E-18 + NE=1.13489 BR=1.11868 NR=1 VAR=4.46837 IKR=8 ISC=8E-15 + NC=1.8 RB=25 RE=0.1220 RC=20 CJE=120.2E-15 VJE=1.0888 MJE=0.381406 + VJC=0.589703 MJC=0.265838 FC=0.1 CJC=133.8E-15 XTF=272.204 TF=12.13E-12 + VTF=10 ITF=0.147 TR=3E-09 XTB=1 XTI=5 KF=7.5E-14 .MODEL NPN NPN + IS=170E-18 BF=100 NF=1 VAF=100 IKF=0.0389 ISE=7.6E-18 + NE=1.13489 BR=1.11868 NR=1 VAR=4.46837 IKR=8 ISC=8E-15 + NC=1.8 RB=250 RE=0.1220 RC=200 CJE=120.2E-15 VJE=1.0888 MJE=0.381406 + VJC=0.589703 MJC=0.265838 FC=0.1 CJC=133.8E-15 XTF=272.204 TF=12.13E-12 + VTF=10 ITF=0.147 TR=3E-09 XTB=1 XTI=5 .MODEL PNP PNP + IS=296E-18 BF=100 NF=1 VAF=100 IKF=0.021 ISE=494E-18

+ NE=1.49168 BR=0.491925 NR=1 VAR=2.35634 IKR=8 ISC=8E-15

```
+ NC=1.8 RB=250 RE=0.1220 RC=200 CJE=120.2E-15 VJE=0.940007
MJE = 0.55
+ VJC=0.588526 MJC=0.55 FC=0.1 CJC=133.8E-15 XTF=141.135
TF=12.13E-12
+ VTF=6.82756 ITF=0.267 TR=3E-09 XTB=1 XTI=5
.ENDS
*
.OPTIONS ACCT LIST OPTS ABSTOL=1pA CHGTOL=.01pC DEFL=100u
DEFW=100u DEFNRD=0
+ DEFNRS=0 DEFPD=0 DEFPS=0 DIGDRVF=2 DIGDRVZ=20K
DIGERRDEFAULT=20 DIGERRLIMIT=0
+ DIGFREQ=10GHz DIGINITSTATE=0 DIGIOLVL=2 DIGMNTYMX=2
DIGMNTYSCALE=0.4 DIGOVRDRV=3
+ DIGTYMXSCALE=1.6 GMIN=1p ITL1=100 ITL2=50 ITL4=10 PIVREL=1m
PIVTOL=.1p RELTOL=1m
+ TNOM=27 TRTOL=7 VNTOL=1u WIDTH=80
.LIB "F:\MC11\library\NOM.LIB"
.TEMP 27
.TRAN 0.0001 5m 0 0.001m UIC
.PLOT TRAN v(OUTPF)
.AC LIN 49999 0.01 1E8
.PLOT AC vDB([OUTPF4]) -200,50
*
. PROBE
.END
;$SpiceType=PSPICE
```

Список литературы:

- 1. Texas Instruments «THS413x High-Speed, Low-Noise, Fully-Differential I/O Amplifiers». SLOS318I –MAY 2000–REVISED AUGUST 2015. p. 20, fig. 41.
- Активный RC-фильтр нижних частот третьего порядка на операционном усилителе с парафазным выходом; МПК: Н03Н 11/12,Н03Н 3/70, G01M 1/22, G01H 17/00 / Денисенко Д.Ю., Бутырлагин Н.В., Титов А.Е., Прокопенко Н.Н. – заявка на патент РФ № 2019105508/08; Заявл. 27.02.19.

- 3. The Antialiasing ARC-LPF with Independent Trimming of the Main Characteristics / D. Denisenko, N. Prokopenko, Y. Ivanov // Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS'2017), Novi Sad, Serbia, September 29 October 2, 2017. Pp. 571-574
- Денисенко Д.Ю., Бутырлагин Н.В., Иванов Ю.И., Прокопенко Н.Н., Активный RC-фильтр для обработки сигналов пьезоэлектрического преобразователя на основе мультидифференциального операционного усилителя [Электронный ресурс] // Институт проблем проектирования в микроэлектронике PAH: [сайт]. [2018]. URL: http://www.ippm.ru/index.php?page=journ&code=J25 (дата обращения: 17.11.2018).
- активный RC-фильтр порядка 5. Низкочувствительный второго С диапазоном/ Денисенко. расширенным частотным Д.Ю. H.H. Прокопенко// VIII Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы разработки перспективных микрои наноэлектронных МЭС-2018., Москва. Сборник трудов / под общ. ред. систем», академика РАН А.Л. Стемпковского. М.: ИППМ РАН, 2018. Выпуск IV. Стр. 17-23.